



关于团体标准 T/CASAS 016—2022 《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）结壳热阻瞬态双界面测试方法》 发布的通知

各联盟成员单位：

按照 CASAS 相关管理办法，团体标准 T/CASAS 016—2022 《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）结壳热阻瞬态双界面测试方法》已遵照流程完成制定工作，现予以发布。

标准编号及名称：**T/CASAS 016—2022 《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）结壳热阻瞬态双界面测试方法》**

主要起草单位：工业和信息化部电子第五研究所、中国电子科技集团第五十五研究所、南方电网科学研究院有限责任公司、国网智能电网研究院有限公司、西安交通大学、东南大学、山东大学、南京航空航天大学、深圳基本半导体有限公司、东莞南方半导体科技有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

主要起草人：付志伟、侯波、周斌、陈思、杨晓锋、陈义强、陈媛、来萍、黄云、路国光、刘奥、郭怀新、李巍巍、李金元、李尧圣、王来利、刘斯扬、杨家跃、崔益军、唐宏浩、乔良、徐瑞鹏。

特此通知。

第三代半导体产业技术创新战略联盟

2022年7月18日

